

# КВАДРУПОЛЬНЫЕ И МАГНИТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В $\text{HoAlO}_3$

Л. С. Воротилова, Л. В. Дмитриева, В. С. Касперович, Р. М. Рахманкулов

Редкоземельные (РЗ) алюминаты—перовскиты  $\text{LnAlO}_3$  представляют интерес как материалы для квантовой электроники и техники СВЧ. Среди них соединения первой половины РЗ ряда, в частности  $\text{LaAlO}_3$ ,  $\text{PrAlO}_3$  и  $\text{EuAlO}_3$ , исследовались различными методами. Значительно менее изучены соединения второй половины ряда, при синтезе которых часто получают смесь двух фаз — перовскита и граната — и выращивание монокристаллов проводить сложнее. В настоящей работе методом ЯМР на ядрах  $^{27}\text{Al}$  исследовались кристаллы  $\text{HoAlO}_3$ , выращенные методом оптической зонной плавки. Они имели форму цилиндра со средними размерами:  $l=7$  мм,  $d=3$  мм.

Алюминат голмия по типу симметрии относится к перовскитам с ромбическим искажением кристаллической решетки, пространственная группа  $P_{bnn}$ <sup>[1]</sup>, точечная симметрия позиции алюминия  $C_1$ . Элементарная ячейка содержит 4 магнитно-неэквивалентных ядра  $^{27}\text{Al}$ .

Ориентационные зависимости спектра ЯМР ядер  $^{27}\text{Al}$  снимались при комнатной температуре при вращении вектора магнитной индукции в плоскости, перпендикулярной оси цилиндрического образца и не содержащей ни одной из кристаллографических осей.

Полученные спектры анализировались по специальной методике, разработанной для случая вращения кристалла в одной произвольной плоскости с учетом определенной симметрии структуры<sup>[2]</sup>.

Обработка экспериментальных результатов дает следующие значения констант квадрупольного взаимодействия:  $e^2qQ/h=1.43 \pm 0.02$  МГц,  $\eta=0.56 \pm 0.05$ .

Матрица, определяющая направление главных осей тензора градиента электрического поля (ГЭП) для одного из четырех центров  $^{27}\text{Al}$ , имеет вид

$$A = \begin{matrix} X & \begin{matrix} a \\ -0.804 \\ -0.111 \\ -0.584 \end{matrix} & \begin{matrix} b \\ -0.514 \\ -0.363 \\ 0.777 \end{matrix} & \begin{matrix} c \\ -0.298 \\ 0.925 \\ 0.235 \end{matrix} \\ Y & & & \\ Z & & & \end{matrix}, \quad (1)$$

$a$ ,  $b$ ,  $c$  — кристаллографические оси. Направляющие косинусы для трех других центров  $^{27}\text{Al}$  получаются заменой знаков в одном из столбцов матрицы  $A$ .

Из (1) следует, что одна из главных осей ГЭП, а именно ось  $Y$ , лежит под углом  $\approx 22^\circ$  к кристаллографической оси  $c$ , а две другие оси  $X$  и  $Z$  отклонены от плоскости  $ab$  на  $\approx 17$  и  $\approx 13^\circ$  соответственно. Подобное расположение главных осей тензора квадрупольного взаимодействия для  $^{27}\text{Al}$  было получено в алюминате иттрия<sup>[3]</sup>.

Расчет квадрупольных параметров, проведенный в рамках модели точечных зарядов при варьировании координат ионов в  $\text{HoAlO}_3$  в пределах указанных в [1] погрешностей, приводит к следующим значениям:  $e^2qQ/h=-3.0 \pm 1.5$  МГц,  $\eta=0.6 \pm 0.3$ .

Несмотря на удовлетворительное согласие с экспериментом в алюминате голмия, метод точечных мультиполей в применении к другим РЗ алюминатам оказывается недостаточным<sup>[4]</sup>. Для объяснения всех имеющихся экспериментальных данных по квадрупольным взаимодействиям в этих кристаллах необходим учет электронного вклада. Такая работа проводится нами в настоящее время.

В заключение обсудим влияние парамагнитных ионов  $\text{Ho}^{3+}$  на спектр ЯМР ядер  $^{27}\text{Al}$ . Ориентационная зависимость центрального перехода

$1/2 \leftrightarrow -1/2$  обусловлена в основном магнитными локальными полями, наводимыми ионами  $\text{Ho}^{3+}$ , так как квадрупольные сдвиги 2-го порядка в данном случае малы. По известной формуле для локального магнитного поля (например, из [5]) с учетом экспериментальных значений параметров сдвигов можно оценить величину среднего магнитного момента иона  $\text{Ho}^{3+}$ . Для комнатной температуры в поле 1 Тл оценка дает

$$\langle m \rangle = (0.15 \pm 0.02) \mu_B,$$

где  $\mu_B$  — магнетон Бора.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Hammann J., Ocio M. // Acta Cryst. 1977. V. A33. N 6. P. 975—978.
- [2] Berglund B., Tegenfeldt J. // J. Magn. Res. 1978. V. 30. N 3. P. 451—455.
- [3] Burum D. P., Macfarlane R. M., Shelby R. M., Mueller L. // Phys. Lett. 1982. V. 91A. N 9. P. 465—468.
- [4] Воротилова Л. С., Дмитриева Л. В., Касперович В. С. // Ядерный магнитный резонанс. 1988. № 7. С. 59—66.
- [5] Bleaney B., Robinson F. R. S., F. N. H., Wells M. R. // Proc. R. Soc. Lond. 1978. V. A362. P. 179—194.

Институт химии силикатов  
им. И. В. Гребенщикова АН СССР  
Ленинград

Поступило в Редакцию  
15 июня 1988 г.  
В окончательной редакции  
24 октября 1988 г.

УДК 537.812.62

Физика твердого тела, том 31, в. 3, 1989  
*Solid State Physics, vol. 31, N 3, 1989*

## АНОМАЛИИ ТЕРМОЭДС И ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ В МЕТАЛЛООКСИДНЫХ КЕРАМИКАХ ИТТРИЕВОЙ ГРУППЫ (80—300 К)

B. Н. Моргун, Н. Н. Чеботаев

В работе приведены результаты исследований температурных зависимостей электросопротивления (ЭС) и абсолютной дифференциальной термоэдс (ТЭ)  $S = \Delta U / \Delta T$  сверхпроводящих металлооксидных керамик (ВТСП) иттриевой группы  $M_1\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ , где  $M = \text{Tm}$  (1),  $\text{Y}'$  (2),  $\text{Y}''$  (3),  $\text{Yb}$  (4) (фаза «один—два—три») в интервале температур 80—300 К. Образцы были приготовлены в одинаковых условиях методом реакций в твердой фазе по стандартной технологии [1, 2]. При этом, однако, образцы несколько отличаются содержанием кислорода, плотностью и параметрами решетки. Образцы практически однофазны и имеют орторомбическую структуру. Электросопротивление измерялось по четырехзондовой схеме с относительной погрешностью  $\sim 0.5\%$ . ТЭ измерялась относительно меди или свинца [3] с абсолютной погрешностью  $\leq 0.05 \text{ мкВ/К}$ . Измерения ЭС и ТЭ проводились как в стационарном, так и в квазистационарном режимах в циклах охлаждение—нагрев. Для температурных зависимостей ЭС и ТЭ наблюдается небольшой гистерезис, т. е. несовпадение хода при охлаждении и нагревании образцов. Все образцы имеют металлический характер проводимости в интервале 95—300 К с квазилинейной зависимостью сопротивления от температуры. Удельное сопротивление при 100 К  $\rho = (0.3—3) \cdot 10^{-5} \text{ Ом} \cdot \text{м}$ , при 300 К оно увеличивается в 2—3 раза, температура сверхпроводящего перехода  $T_c \sim 91 \div 93 \text{ К}$ , ширина перехода  $\Delta T \sim 1 \div 2 \text{ К}$ .

Для ТЭ, так же как и для ЭС, наблюдается СП переход при  $T \sim 92 \text{ К}$  с падением эдс СП при  $T < 92 \text{ К}$  до «нуля». В области температур 100—300 К ТЭ принимает в зависимости от типа образца (в первую очередь —